

1. 請解釋下列名詞：(20%)
 - (a) 齊納崩潰(zener breakdown)。
 - (b) Clausius-Mosotti's equation。
 - (c) Hume-Rothery rule。
 - (d) 集膚效應(skin effect)。
 - (e) 混合法則(mixture rule)。
2. (a)鈦酸鋇($BaTiO_3$)具有多種結晶構造，請說明其溫度與結晶構造的關係。(5%)
(b)請說明居里點(Curie Point)與轉相溫度(transition temperature)的差異。(5%)
3. 已知純矽晶體的相對介電常數 ϵ_r 是 11.9，其單位體積的原子密度為 $5 \times 10^{28}/m^3$ 。試求其：(15%)
 - (a).電子極化率。
 - (b). 在矽晶體的兩面加上電極，並加入一電場，試求其局部場是外加電場的幾倍。
 - (c).相對應的共振頻率。
4. 在 27°C 時銨的電子漂移速率為 $6cm^2/V\cdot s$ ，電阻係數為 $8.37 \times 10^{-8}\Omega\cdot m$ ，其原子量及密度分別為 114.82amu(g/mole) 與 $7.31g/cm^3$ ，試求：
 - (a). 每一個銨原子所提供的傳導電子。(5%)
 - (b). 若傳導電子的平均速度為 $1.74 \times 10^8 cm/s$ ，試求其平均自由路徑。(5%)
 - (c). 其熱傳導係數。(5%)
5. 已知 300K 時銅的霍爾係數與導電係數分別是 $-0.55 \times 10^{-10} m^3/A\cdot s$ 及 $5.9 \times 10^7/\Omega\cdot m$ 。試求銅的霍爾移動率及其傳導電子數。(10%)
6. CsCl 晶體的格子參數 $a=0.412nm$ ， Cs^+ 的電子極化率為 $3.35 \times 10^{-40} f/m^2$ ，而 Cl^- 的電子極化率為 $3.40 \times 10^{-40} f/m^2$ ，同時離子對的平均離子極化率為 $6 \times 10^{-40} f/m^2$ ，試求 CsCl 低頻與高頻的介電常數。(10%)
7. 順電材料與強電材料有何差異？(10%)
8. 一個矽(Si)單-側陡接面， $N_A = 10^{19} cm^{-3}$ 且 $N_D = 10^{16} cm^{-3}$ ，請計算其空乏層之厚度及在零偏壓下最大的電場 ($T = 300 K$) (10%)